

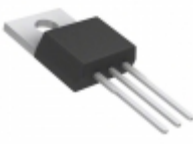
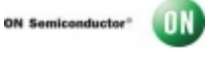




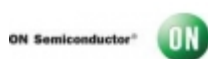
	<b>FDP8N50NZ</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FDP8N50NZ
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V TO-220AB-3
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FDP8N50NZ.pdf</a> <a href="#">2.FDP8N50NZ.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5337 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP8N50NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V TO-220AB-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5337 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 8A (Tc) 130W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	130W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	735pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP8N50NZ ist neu im Original. Suche FDP8N50NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP8N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP8N50NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDPC1002S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p><b>FDP8896</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 92A TO-220AB</p>	 <p><b>FDPC3D5N025X9D</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2 N-CH 25V 74A 12-PQFN</p>	 <p><b>FDP8N50NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V TO-220AB-3</p>
 <p><b>FDPC1002S</b> FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p><b>FDP8896</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 92A TO-220AB</p>	 <p><b>FDPC4044</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 8MLP</p>	 <p><b>FDP8D5N10C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙ FDP75N08-0606	➔ FDP75N08A	➔ FDP75N08A	D FDP75N80A	➔ FDP79N15
➔ FDP79N15	⚙ FDP7N50F	D FDP7N50U	➔ FDP7N60NZ	➔ FDP7N60NZ
⚙ FDP8030A	➔ FDP8030L	⚙ FDP8030L	➔ FDP80N06	➔ FDP80N06
D FDP8441_F085	⚙ FDP8441_F085	➔ FDP8442_F085	⚙ FDP8443_F085	➔ FDP8447L
➔ FDP8447L	➔ FDP8870_F085	⚙ FDP8874-NL	➔ FDP8896-08	➔ FDP8896_F085
➔ FDP8N50NZ	➔ FDPC1002S	D FDPC1002S	⚙ FDPC5018SG	➔ FDPC5018SG
⚙ FDPC8013S	D FDPC8013S	➔ FDPC8016S	➔ FDPC8016S	➔ FDPF035N06B
➔ FDPF035N06B_F152	⚙ FDPF041N06BL1	➔ FDPF041N06BL1	➔ FDPF045N10A	➔ FDPF045N10A
⚙ FDPF085N10A	➔ FDPF085N10A	⚙ FDPF10N50FT	D FDPF10N50FT	➔ FDPF10N50UT
➔ FDPF10N50UT	⚙ FDPF10N60NZ	➔ FDPF10N60NZ	⚙ FDPF10N60ZUT	➔ FDPF10N60ZUT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited